共沉淀法制备 Co 掺杂 ZnO 的室温铁磁性的研究*

严国清¹²) 谢凯旋¹) 莫仲荣¹) 路忠林³) 邹文琴¹) 王 申¹)

岳凤 \mathfrak{g}^{1} 吴 \mathfrak{g}^{1} 张凤 \mathfrak{g}^{1} 都有 \mathfrak{h}^{1}

1 (南京大学物理系,南京 210093)
2 (宿州学院物理与电子工程系,宿州 234000)
3 (东南大学物理系,南京 210096)
(2008 年 7 月 6 日收到 2008 年 8 月 6 日收到修改稿)

利用共沉淀法并在 5vol. % H₂/Ar 气流中于 300 ℃退火 3 h ,制备了 $Zn_{1-x}Co_xO$ 稀磁半导体. 扫描电子微探针分 析表明 ,对 Co 的名义组分分别为 0.05 ρ .10 ρ .15 的样品 ,其实际组分分别为 x = 0.054 ,0.100 和 0.159. X 射线衍射 表明 ,主相为纤锌矿结构 , x = 0.100 和 0.159 的样品中含有 CoO 杂相. X 射线光电子谱显示出 Co 有 3 种状态:替 代进入 ZnO 晶格、CoO 和金属 Co. 通过磁性测量 ,发现所有样品都具有室温铁磁性 ,但是磁性是非本征的 ,一方面 来自金属 Co 团簇的磁性 ,另一方面来自 Zn 掺杂 CoO_{1-a}的弱磁性.

关键词:稀磁半导体,ZnO,共沉淀法,磁性来源 PACC:7550P,7550E

1.引 言

自从 1988 年巨磁电阻(GMR) 效应发现[1]以来, 自旋电子学受到越来越多的关注,因为它在信息技 术方面具有巨大应用价值^{2,3]}.用于自旋电子学的 新颖材料主要有半金属和稀磁半导体、对干稀磁半 导体,人们期望开发出居里温度高于室温的材料来 制备自旋电子器件,所以 2000 年 Dietl 等⁴ 关于 ZnO基稀磁半导体中存在室温铁磁性的理论预言激 起了大量有关的理论和实验工作,另外,纯 ZnO 是 一种多功能材料,具有压电、光电、气敏、压敏等多 种优良性能. 至今, 在过渡金属掺杂的 ZnO 方面已 经取得了非常多的实验结果,但是其磁性来源仍然 没有完全搞清楚,甚至有些结果相互之间存在矛 盾. Fukumura 等^[5]于 2001 年对 Mn 掺杂 ZnO 最早开 展了实验工作,采用脉冲激光沉积法以蓝宝石为衬 底于 600 ℃在低的氧分压下生长 Zn_{0.64} Mn_{0.36} O 薄膜, 样品中存在强的反铁磁交换耦合并且在 13 K 以下 出现自旋玻璃态, 相反 Sharma 等 $^{[6]}$ 第一次在 Mn 掺 杂小于 4at. %的 ZnO 块材、薄膜和粉末中发现了室

温铁磁性,样品的处理温度低于 700 ℃.不过 Kundaliya 等^[7]后来证实铁磁性是非本征的,来自亚 稳相 Mn_{2-x}Zn_xO_{3-δ}.

关于 Co 掺杂 ZnO ,Ueda 等^{8]}首先发现用脉冲激 光沉积法制备的共掺 1wt.% Al 的 Zn1-x Cox O(x 为 0.05-0.25)薄膜的居里温度接近室温 但是重复率 低于 10%. Rode 等^[9]用脉冲激光沉积法制备 Co 掺 杂 ZnO 薄膜 发现在低的氧分压下生长的样品具有 铁磁性. Schwartz 等¹⁰发现用溶胶-凝胶法制备的 Co ZnO 薄膜在 Zn 蒸气中处理后具有室温铁磁性, 但处理前为顺磁, Kittilstved 等¹¹用金属有机物化 学气相沉积法制备 Co ZnO 薄膜 然后在 Zn 蒸气中 处理后,亦发现了室温铁磁性. 最近有人提出,具有 大的高频介电常数的稀磁氧化物的高温铁磁性可能 来自浅施主电子形成的束缚磁极化子(BMP)^{12,13}] BMP 模型可以解释关于 Co 掺杂 ZnO 的许多实验结 果、氧空位、间隙 Zn 缺陷和 n 型掺杂(如 Al)都可以 提供浅施主电子从而诱导出铁磁性. 然而, Tuan 等^{14]}采用金属有机物化学气相沉积法制备 Co 掺杂 ZnO 薄膜 发现共掺 Al 既不能产生 n 型导电也不能 诱导铁磁性,只有真空退火导致的氧空位才能产生

^{*}国家重点基础研究发展计划(批准号 2005CB623605)和安徽省教育厅重点自然科学研究项目(批准号:KJ2008A26ZC)资助的课题。

[†] 通讯联系人.E-mail:fmzhang@nju.edu.cn

至于氢气氛退火对 Co 掺杂 ZnO 磁性的影响, Lee 等^{15]}认为铁磁性来自以吸附的氢为媒介的自旋 -自旋交换作用; Deka 等^{16]}发现铁磁性来自钴团簇; 而王漪等^{17]}用固相反应法制备 Co 掺杂 ZnO 然后在 10vol.%H₂/Ar 气氛中退火,样品表现出室温铁磁 性 他们认为磁性不是来自钴团簇 如果氢气氛退火 产生了氧空位 磁性还可以用 BMP 模型解释,为了 进一步澄清氢气氛退火下 Co 掺杂 ZnO 的磁性来 源 我们用共沉淀法制备了 $Zn_{1-x}Co_xO(x = 0.054)$, 0.100 0.159)纳米晶 然后在 5vol. % H₂/Ar 气流中退 火. 共沉淀法是一种低温简便的方法,可以实现微 量掺杂的均匀分布,我们发现所有样品都表现出室 温铁磁性而且包含两个铁磁相, 而 Bouloudenine 等^[18]用共沉淀法生成草酸盐前驱体 Zn_{1-x} Co_x (C₂O₄)·2H₂O(x在0-0.1之间),然后在空气中于 1173 K加热 15 min 样品是顺磁与反铁磁的混合 而 且反铁磁成分随 x 增大而增多. 刘学超等^[19]以 ZnO 和 Co₃O₄ 为原料采用固相反应法在氩气氛中于 1173 K 烧结 20 h,制备出 Zn0.95 Co0.05 O 块材,样品表现为 顺磁性 而且 Co 离子之间存在反铁磁交换作用,这 与 Bouloudenine 等的结果很类似,我们的样品磁性 与他们的都不同,主要是因为处理气氛不同,

2.实 验

样品制备过程如下:纯度高于 99.0%的 Zr(NO₃)₂·6H₂O和 Cd(NO₃)₂·6H₂O 按名义组分混合 然后溶入去离子水中,盛有溶液的烧杯放在 40 ℃水 浴中并搅拌 5 min 使之完全溶解,然后加入适量的 浓度为 25%的氨水使 pH 值约为 8,同时搅拌 30 min,再在水浴中陈化 30 min.取出烧杯倒入大量去 离子水,静置 1.5 h 后倒掉上层清液,剩余的用滤纸 过滤后仍放回烧杯.将烧杯放入烘箱于 105 ℃烘烤 3 h 以蒸干水分并使得残留的 NH₄NO₃ 完全分解,再 于 145 ℃烘烤 4 h 使得氢氧化物分解为氧化物.将 所得物质研磨后压制成直径 9 mm、厚约 2 mm 的圆 片,放入石英管中在 5vol.%H₂/Ar 气流中于 300 ℃ 退火 3 h,再随炉冷却到室温.这样就得到了松软的 苔绿色样品.

扫描电子微探针分析发现 Co 的名义组分分别 为 0.05 ρ .10 和 0.15 的样品的实际组分依次为 $x = 0.054 \rho$.100 和 0.159. 用 X 射线衍射仪对粉末样品

的结构和相纯度进行了表征,用振动样品磁强计 (VSM 测量了室温的磁滞回线以及高温区磁化强度 对温度的依赖关系,还采用 X 射线光电子谱表征了 Co 的价态.

此外,为了研究样品磁性来源,采用同样方法制 备了 CoO,并用 VSM 测量了其高温区磁化强度对温 度的依赖关系.

3.结果与讨论

图 1 的 X 射线衍射图谱表明,所有样品的主相 均为纤锌矿结构,随 x 增大衍射峰位基本不变.因 为四面体构型中 Co^{2+} 和 Zn^{2+} 的半径很接近:根据文 献 20],二者离子半径之比 $r_{Co}/r_{Zn} = 0.96$;根据文献 [19], $r_{Co} = 0.058$ nm, $r_{Zn} = 0.060$ nm. 根据 Sherrer 公 式 3 个样品的平均晶粒尺寸均为 27 nm. 另外,x =0.100 和 0.159 的样品出现了立方 CoO 杂相,图中用 ↓标出的是其(200)面对应的衍射峰.



图 1 粉末样品 $Zn_{1-x}Co_x$ (x = 0.054 0.100 0.159)的 X 射线衍 射图谱 采用 CuK_a 射线,用 \downarrow 标出的衍射峰对应于 CoO 杂相的 (200)面

图 2 给出了室温下用 VSM 测得的磁滞回线,所 有样品都表现出铁磁性. x = 0.054 ,0.100 和 0.159 样品的每个 Co 原子的平均饱和磁化强度依次为 0.30 0.32 和 $0.35\mu_B$,其矫顽力依次为 38 ,84 和 104 Oe(1 Oe = 79.5775 A/m). 有趣的是磁滞回线呈现蜂 腰形,说明样品中存在矫顽力不同的两个铁磁相.

为了进一步证实样品中是否有两个铁磁相共存,我们用 VSM 测量了 293 和 573 K 之间的磁化强度对温度的依赖关系,外加磁场 5000 Oe,测量中通Ar 气流保护. 如图 3 所示,所有样品在 373 和 473 K





之间均发生了磁相变,然后升温直至 573 K 磁化强 度基本保持不变.对于居里温度高于 573 K 的铁磁 相 我们认为是来自还原性气氛退火形成的金属 Co 团簇. 设单个 Co 原子的磁矩为 $1.7\mu_{\rm B}$ 即金属 Co 的 饱和磁化强度为 161 emu/g 则根据图中的磁化强度 值 可以估算出每克 x = 0.054, 0.100 和 0.159 样品 中金属 Co 的含量依次为 0.0046 ,0.0088 和 0.0120 g,所以 X 射线衍射不能检测出 Co 团簇的存在. x =0.054 0.100 和 0.159 的样品中还存在另外一个铁 磁相 居里温度依次为 453 A73 和 483 K. 该相可能 来自 Co 替代进入 ZnO,也可能来自纳米 CoO 杂相. 为了弄清它的真正来源,我们后来用同样的方法制 备了 CoO 并用 VSM 测量了室温至 673 K 的磁化强 度(开始测至 573 K,发现磁化强度有明显下降却 未出现居里点,所以继续升温至 673 K),外加磁场 5000 Oe. 结果如图 4 所示,出现了两个铁磁相:一 个的居里温度高于 673 K,另一个的居里温度约为 658 K. 前者是金属 Co 后者为还原性气氛中形成的 具有氧空位的 C_0O_{1-x} . 这就说明 x = 0.054, 0.100 和 0.159 样品中另一个铁磁相来自 CoO 杂相,不过 其居里温度比 658 K 低 因为 CoO 杂相实际上被掺 入了少量 Zn,同时受还原性气氛影响,成为 Co1-, $Zn_x O_{1-x}$,其居里温度随 γ 增大而减小. x = 0.054, 0.100和0.159样品中另一个铁磁相的居里温度随 x 增大而缓慢增大 进一步证实了这一观点. 另外, 设单个 Co 原子的磁矩为 1.7 μB, 根据图 4 可以估算 出每克样品中有 0.48 g 金属 Co 那么就有 0.52 g 的 CoO_{1-3} . 再根据图 4 即可估算出 CoO_{1-3} 的饱和磁化 强度为 11.2 emu/g,这个值比晶粒为 9 nm 的纳米

CoO 的室温磁化强度要高得多^[21],因为氧空位使得 更多的 Co 原子之间产生平行或倾斜的耦合. 根据 这个值并结合图 3,不考虑 Zn 掺杂对 CoO₁₋₃饱和磁 化强度的影响,我们估算出每克 x = 0.054 0.100 和 0.159 样品中分别有 0.02 0.05 和 0.10 g 的 Zn 掺杂 CoO₁₋₃. 扣除 Co 元素的金属团簇状态和 Zn 掺杂 CoO₁₋₃, 状态(假设 Zn 掺杂量可忽略不计),在 x =0.054 0.100 和 0.159 样品中分别有 2.7% 3.7% 和 4.0% 的 Zn 被 Co 替代.



图 3 样品 Zn_{1-x}Co_xO(x = 0.054 0.100 0.159)在 5000 Oe 磁场 下在高温区的磁化强度随温度的变化关系



图 4 样品 CoO 在 5000 Oe 磁场下在高温区的磁化强度随温度的变化关系

为了进一步研究和证实 Co 的价态 ,测量了 3 个 样品的 X 射线光电子谱 ,如图 5 所示.结合能已根 据 C 1s 的峰位(284.6 eV)进行校准. Co 2p_{1/2}和 Co 2p_{3/2}主峰都伴随有明显的振荡卫星峰 ,表明 Co 主要 处在 + 2 价^[14].值得注意的是 ,Co²⁺ 的 2p_{3/2}主峰出 现了宽化并且有两个次峰.根据相关结果^[14,15],用 、标出的在 780.1 eV 附近的次峰对应于 CoO ,另一



图 5 样品 Zn_{1-x}Co_xO(x = 0.054 0.100 0.159)的 Co 2p 的 X 射 线光电子谱 用↓标出的峰对应于金属 Co 的 2p_{3/2} ,用 ↓标出的 峰对应于 CoO 的 2p_{3/2} 主峰

个结合能更高的次峰对应于 Co 替代进入 ZnO. 而 且 CoO 对应的次峰的相对强度随 x 增大而增大,说 明 CoO 的比例在增大,这与 X 射线衍射的结果以及 上一段的讨论都是一致的. 此外,x = 0.100和0.159 的样品在 777.3 eV 附近出现明显的峰,对应于金属 Co 的 $2p_{32}$ ^[15]. 因此,X 射线光电子谱测量进一步证

- [1] Baibich M N, Broto J M, Fert A, van Dau F N, Petroff F, Eitenne P, Creuzet G, Friederich A, Chazelas J 1988 Phys. Rev. Lett. 61 2472
- [2] Wolf S A, Awschalom D D, Buhrman R A, Daughton J M, von Molnár S, Roukes M L, Chtchelkanova A Y, Treger D M 2001 Science 294 1488
- [3] Žutić I , Fabian J , Sarma S D 2004 Rev. Mod. Phys. 76 323
- [4] Dietl T , Ohno H , Matsukura F , Cibert J , Ferrand D 2000 Science 287 1019
- [5] Fukumura T, Jin Z W, Kawasaki M, Shono T, Hasegawa T, Koshihara S, Koinuma H 2001 Appl. Phys. Lett. 78 958
- [6] Sharma P , Gupta A , Rao K V , Owens F J , Sharma R , Ahuja R , Guillen J M O , Johansson B , Gehring G A 2003 Nat . Mater . 2 673
- [7] Kundaliya D C , Ogale S B , Lofland S E , Dhar S , Metting C J , Shinde S R , Ma Z , Varughese B , Ramanujachary K V , Salamanca-Riba L , Venkatesan T 2004 Nat . Mater . 3 709
- [8] Ueda K , Tabata H , Kawai T 2001 Appl . Phys . Lett . 79 988
- [9] Rode K, Anane A, Mattana R, Contour J P, Durand O, LeBourgeois R 2003 J. Appl. Phys. 93 7676
- [10] Schwartz D A , Gamelin D R 2004 Adv. Mater. 16 2115
- [11] Kittilstved K R , Schwartz D A A C , Heald S M , Chambers S A , Gamelin D R 2006 Phys. Vev. Lett. 97 037203

实 Co存在 3 种状态: 替代进入 ZnO 晶格、CoO 和金属 Co. 顺便提一下,我们的 x = 0.054 样品就已出现 杂相 CoO,而用脉冲激光沉积法制备的 Zn_{0.75} Co_{0.25} O 仍保持为单相^[8]. 根据 Erwin 等的理论^[22],半导体 纳米晶的掺杂机制是生长过程中杂质在纳米晶表面 的吸附 纤锌矿结构的纳米晶的任何一个晶面都不 能对杂质提供有效束缚,所以我们的纳米晶样品不 能进行特别有效地掺杂.

4.结 论

我们用共沉淀法制备了 Co 掺杂 ZnO,并在 5vol.%H₂/Ar 气流中进行退火,实现了室温铁磁性. 但是磁性不是来自稀磁半导体的本征磁性,而是来 自 Zn 掺杂 CoO₁₋。的弱磁性与金属 Co 团簇的铁磁性 的混合.为了直接证实 Zn 掺杂会使得 CoO₁₋。的居 里温度下降,应该研究 Zn 掺杂 CoO 系统,进一步的 工作正在进行中.

感谢西南大学物理系陈鹏教授在 VSM 测量上提供的帮助.

- [12] Venkatesan M, Fitzgerald C B, Lunney J G, Coey J M D 2004 Phys. Rev. Lett. 93 177206
- [13] Coey J M D, Venkatesan M, Fitzgerald C B 2005 Nat. Mater. 4 173
- [14] Tuan A C , Bryan J D , Pakhomov A B , Shutthanandan V , Thevuthasan S , McCready D E , Gaspar D , Engelhard M H , Rogers J W , Krishnan K , Gamelin D R , Chambers S A 2004 Phys. Rev. B 70 054424
- [15] Lee H J , Park C H , Jeong S Y , Yee K J , Cho C R , Jung M H , Chadi D J 2006 Appl. Phys. Lett. 88 062504
- [16] Deka S , Joy P A 2006 Appl . Phys . Lett . 89 032508
- [17] Wang Y, Sun L, Han DD, Liu LF, Kang JF, Liu XY, Zhang X, Han RQ 2006 Acta Phys. Sin. 55 6651 (in Chinese)[王 滴、孙 雷、韩德栋、刘力锋、康晋锋、刘晓彦、张 兴、韩汝琦 2006 物理学报 55 6651]
- [18] Bouloudenine M, Viart N, Colis S, Kortus J, Dinia A 2005 Appl. Phys. Lett. 87 052501
- [19] Liu X C, Shi E W, Song L X, Zhang H W, Chen Z Z 2006 Acta Phys. Sin. 55 2557 (in Chinese)[刘学超、施尔畏、宋力昕、张 华伟、陈之战 2006 物理学报 55 2557]
- [20] Yoo Y Z , Fukumura T , Jin Z W , Hasegawa K , Kawasaki M , Ahmet P , Chikyow T , Koinuma H 2001 J. Appl. Phys. 90 4246

- [21] Tomou A, Gournis D, Panagiotopoulos I, Huang Y, Hadjipanayis G C, Kooi B J 2006 J. Appl. Phys. 99 123915
- [22] Erwin S C , Zu L J , Haftel M I , Efros A L , Kennedy T A , Norris D J 2005 Nature 436 91

Room-temperature ferromagnetism in Co-doped ZnO fabricated by coprecipitation method *

Yan Guo-Qing^{1,2}) Xie Kai-Xuan¹) Mo Zhong-Rong¹) Lu Zhong-Lin³) Zou Wen-Qin¹)

Wang Shen¹) Yue Feng-Juan¹) Wu Di¹) Zhang Feng-Ming¹[†] Du You-Wei¹)

1 Department of Physics , Nanjing University , Nanjing 210093 , China)

2 X Department of Physics and Electronic Engineering , Suzhou College , Suzhou 234000 , China)

3 X Department of Physics , Southeast University , Nanjing 210096 , China)

(Received 6 July 2008; revised manuscript received 6 August 2008)

Abstract

Nanocrystalline $\operatorname{Zn}_{1-x} \operatorname{Co}_x O$ samples were prepared by coprecipitation and annealing at 300 °C for 3 h in 5vol. % H₂/Ar flow. Scanning electron microprobe measurements indicate that the samples with nominal Co contents of 0.05, 0.10, and 0.15 have the actual Co contents of 0.054, 0.100, and 0.159 respectively. X-ray diffraction patterns show that the major phase of the samples is of wurtzite structure, while the minor phase of CoO is observed in samples with Co contents of x = 0.100 and 0.159. X-ray photoelectron spectroscopy shows that Co has three states : Co incorporated into ZnO matrix, CoO and metallic Co. It was found through magnetic measurements, that room-temperature ferromagnetism exists in all the samples and it comes from both the weak ferromagnetism of Zn-doped $\operatorname{CoO}_{1-\delta}$ and the magnetism of metallic Co clusters.

Keywords : diluted magnetic semiconductors , ZnO , coprecipitation method , origin of magnetism PACC : 7550P , 7550E

^{*} Project supported by the National Basic Research Program of China (Grant No. 2005CB623605) and the Key Program of Natural Science Research of Anhui Education Department, China (Grant No. KJ2008A26ZC).

[†] Corresponding author. E-mail : fmzhang@nju.edu.cn